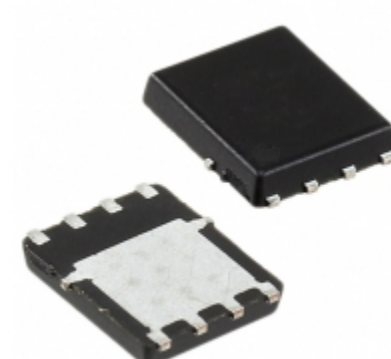


SI7758DP-T1-GE3	
Número de pieza	SI7758DP-T1-GE3
Fabricante	Vishay / Siliconix
Descripción	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
cantidad disponible	5940 pcs in stock
Hojas de datos	SI7758DP-T1-GE3.pdf
SI7758DP-T1-GE3 Price	Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com


[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

Información técnica de SI7758DP-T1-GE3			
Número de pieza del fabricante	SI7758DP-T1-GE3	Categoría	Productos Semiconductores Discretos
Fabricante	Vishay / Siliconix	Descripción	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Paquete / caja	Tape & Reel (TR)	cantidad disponible	5940
Serie	SkyFET®, TrenchFET®	Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)	Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete / Cubierta	PowerPAK® SO-8	Paquete del dispositivo	PowerPAK® SO-8
La disipación de energía (máximo)	6.25W (Ta), 104W (Tc)	Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-	Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	60A (Tc)	RDS (Max) @Id, Vgs	2.9 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	2.7V @ 250µA	Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	160nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	7150pF @ 15V	embalaje	Tape & Reel (TR)

PC SI7758DP-T1-GE3 5940 Nuevas y originales en stock, Encuentre inventario SI7758DP-T1-GE3, Hoja de datos, PDF, Inventario en Ariat-Tech .com Online, Ordene SI7758DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix con garantía y confianza. RFQ SI7758DP-T1-GE3: Info@Ariat-Tech.com

Partes relacionadas para SI7758DP-T1-GE3				
Imagen	Número de pieza	Descripción	Fabricante	Cantidad
	SI7748DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	45000 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	3000 pcs
	SI7738DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	5478 pcs
	SI7758DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	5940 pcs
	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-E3 VISHAY	Vishay	500 pcs
	SI7742DP	SI7742DP SI	SI	404 pcs
	SI7738DP-T1-E3	MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	9100 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	3000 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	2196 pcs
	SI7738DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 150V 30A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	5478 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	2196 pcs
	SI7742DP-T1-E3	SI7742DP-T1-E3 VISHAY	Vishay	1404 pcs
	SI7772DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	17565 pcs
	SI7772DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	17565 pcs
	SI7758DP	SI7758DP VB	VB	1000 pcs
	SI7742DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	1000 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	1000 pcs
	SI7742DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	1000 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	1000 pcs
	SI7748DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	45000 pcs

Módulo IC Chips & IGBT - Número de pieza de stock activo

SI7716ADN-T1-GE3	SI7716ADN-T1-GE3	SI7716ADN-T1-GE3	SI7716DN-T1-GE3	SI7720DN-T1-E3
SI7720DN-T1-GE3	SI7720DN-T1-GE3	SI7726DN	SI7726DN-T1-E3	SI7726DN-T1-GE3
SI7726DN-T1-GE3	SI7732DP-T1-GE3	SI7738DP	SI7738DP-T1-3	SI7738DP-T1-E3
SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-GE3	SI7738DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-E3	SI7742DP-T1-GE3
SI7742DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3
SI7772DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3
SI7784DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-GE3
SI7790DP-T1-GE3	SI7792DP-T1-GE3	SI7794DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN
SI7804DN-T1-E3	SI7804DN-T1-E3	SI7806ADN	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3
SI7806ADN-T1-E3-PBF	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3	SI7806BDN

Distribuidor de componentes electrónicos - Chips de CI y amplificadores; Proveedor de módulos IGBT.

RFQ Email: Info@ariat-tech.com Sitio web: <https://www.ariat-tech.com>

Aviso de derechos de autor © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Todos los derechos reservados.